

平成 25 年度 三洋半導体・群馬大学連携大学院

博士後期課程：次世代集積回路工学特論／博士前期課程：集積回路設計技術

5 月 16 日（14:20～15:50,16:00～17:30）総合研究棟 5 0 2 号室 講義概要

イントロダクトリートーク

三洋半導体株式会社 LSI 事業部 開発企画部 大石橋 康雄

半導体デバイスの基礎として、エネルギーバンドの概念、n 型、p 型半導体のキャリア密度、移動度、拡散・ドリフト電流について触れる。また p-n 接合ダイオードについて電流-電圧特性や降伏現象について述べる。

Bipolar デバイスについて、基本動作原理、電流増幅率、動作状態の基本を学ぶ。また基本断面構造、平面構造から **Bipolar** の重要な特性が何かを理解する。

以上